

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-68593

(P2000-68593A)

(43) 公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl.

H01S 5/30

識別記号

P I

H01S 3/18

キーワード(参考)

5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平10-238695

(22) 出願日 平成10年8月25日(1998.8.25)

(71) 出願人 000008013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 中山 毅

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72) 発明者 川津 晋平

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74) 代理人 100082144

弁理士 青山 稔 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 選択成長法により結晶性の良い窒化物半導体レーザを提供すること、及び活性領域の電流経路幅の調整が容易な窒化物半導体レーザを提供することを目的とする。

【解決手段】 半導体基板を用い、その上に窒化物半導体を選択成長させて積層構造を形成するとともに、その積層構造の作製中、中間段階でストライプ状の開口部を有する高電気抵抗層を1層以上挿入する。

